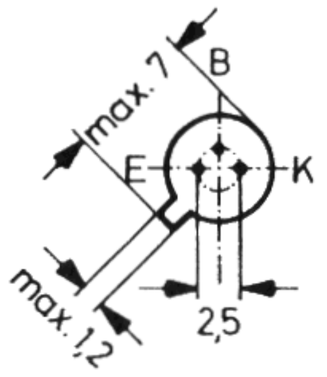
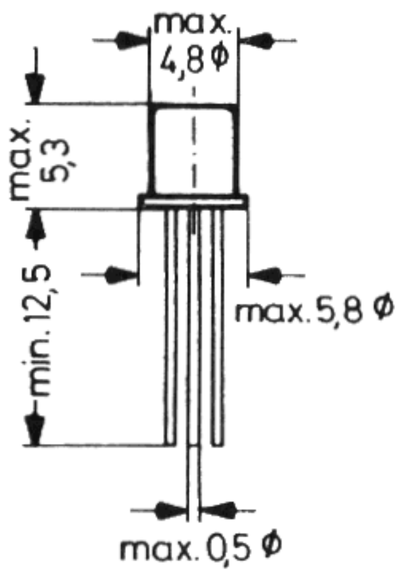
BSW 72, BSW 73, BSW 74, BSW 75

PNP-Silizium-Epitaxie-Planar-Transistoren
mit hoher Grenzfrequenz und kurzen Schaltzeiten

www.datasheetcatalog.com





Metallgehäuse JEDEC TO-18
18 A 3 nach DIN 41 876
Gewicht ca. 0,35 g
Kollektor mit Gehäuse verbunden
Maße in mm

Grenzwerte		**BSW 72 BSW 73**	**BSW 74 BSW 75**	
Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CB0}$	40	75	V
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CE0}$	25	40	V
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EB0}$	5	5	V
Kollektorspitzenstrom	$-I_{CM}$	500		mA
Verlustleistung				
bei $T_U = 25$ °C	P_{tot}	400		mW
bei $T_G = 25$ °C	P_{tot}	1,8		W
Sperrschichttemperatur	T_j	200		°C
Lagerungstemperaturbereich	T_S	− 50 . . + 200		°C

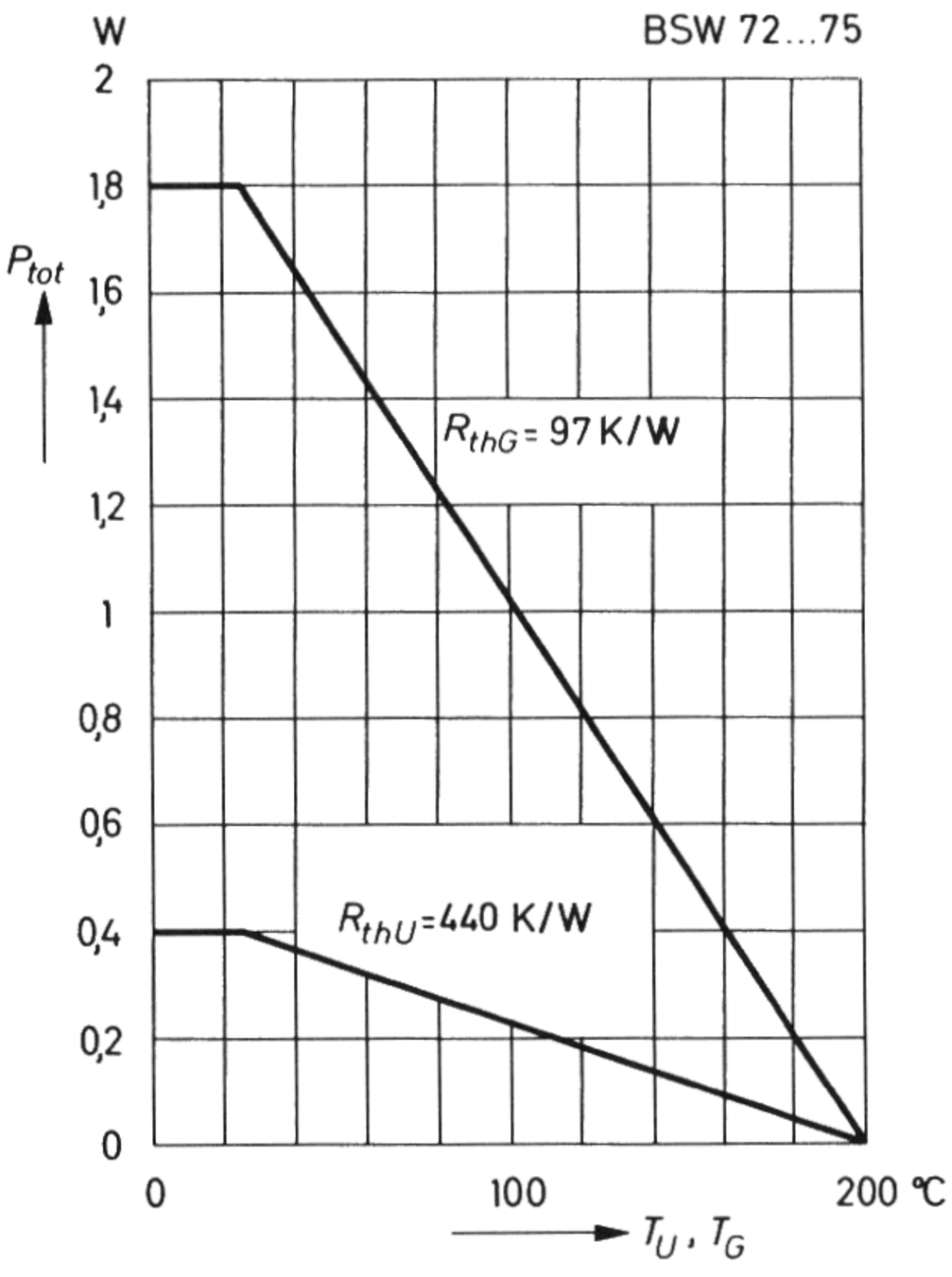
Kennwerte bei $T_j = 25$ °C

		BSW 72	**BSW 73**	**BSW 74**	**BSW 75**	
Kollektor-Basis-Stromverhältnis						
bei $-U_{CE} = 10$ V, $-I_C = 0{,}1$ mA	B	−	−	> 20	> 35	
bei $-U_{CE} = 10$ V, $-I_C = 10$ mA	B	> 30	> 70	> 35	> 75	
bei $-U_{CE} = 10$ V, $-I_C = 150$ mA	B	40 . . 120	100. . 300	40 . . 120	100 . . 300	
bei $-U_{CE} = 10$ V, $-I_C = 500$ mA	B	−	−	> 20	> 40	
Kollektor-Sättigungsspannung						
bei $-I_C = 150$ mA, $-I_B = 15$ mA	$-U_{CEsat}$	< 0,6	< 0,6	< 0,4	< 0,4	V
bei $-I_C = 500$ mA, $-I_B = 50$ mA	$-U_{CEsat}$	−	−	< 1,6	< 1,6	V
Basis-Sättigungsspannung						
bei $-I_C = 150$ mA, $-I_B = 15$ mA	$-U_{BEsat}$	< 1,3	< 1,3	< 1,3	< 1,3	V
bei $-I_C = 500$ mA, $-I_B = 50$ mA	$-U_{BEsat}$	−	−	< 2,6	< 2,6	V
Kollektorreststrom						
bei $-U_{CB} = 30$ V	$-I_{CB0}$	< 100	< 100	−	−	nA
bei $-U_{CB} = 50$ V	$-I_{CB0}$	−	−	< 10	< 10	nA
bei $-U_{CB} = 30$ V, $T_j = 125$ °C	$-I_{CB0}$	< 100	< 100	−	−	µA
bei $-U_{CB} = 50$ V, $T_j = 125$ °C	$-I_{CB0}$	−	−	< 10	< 10	µA

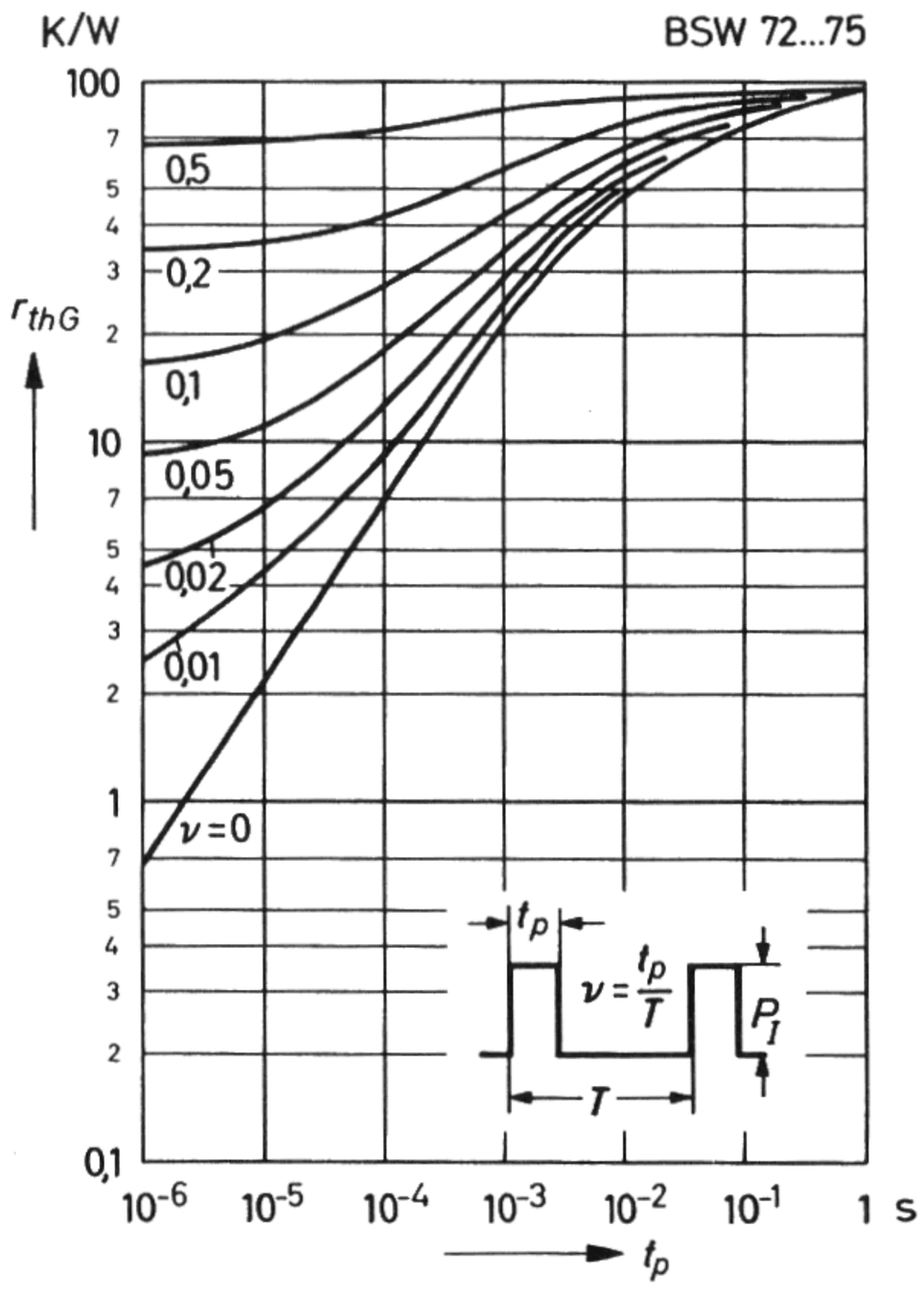
Emitterreststrom bei $-U_{EB} = 3$ V	$-I_{EB0}$	< 100	nA
Transitfrequenz bei $-U_{CE} = 20$ V, $-I_C = 50$ mA, $f = 100$ MHz	f_T	> 150	MHz
Kollektor-Basis-Kapazität bei $-U_{CB} = 10$ V, $f = 100$ kHz	C_{CB0}	< 8	pF
Wärmewiderstand			
Sperrschicht – umgebende Luft	R_{thU}	< 440	K/W
Sperrschicht – Gehäuse	R_{thG}	< 97	K/W

www.datasheetcatalog.com

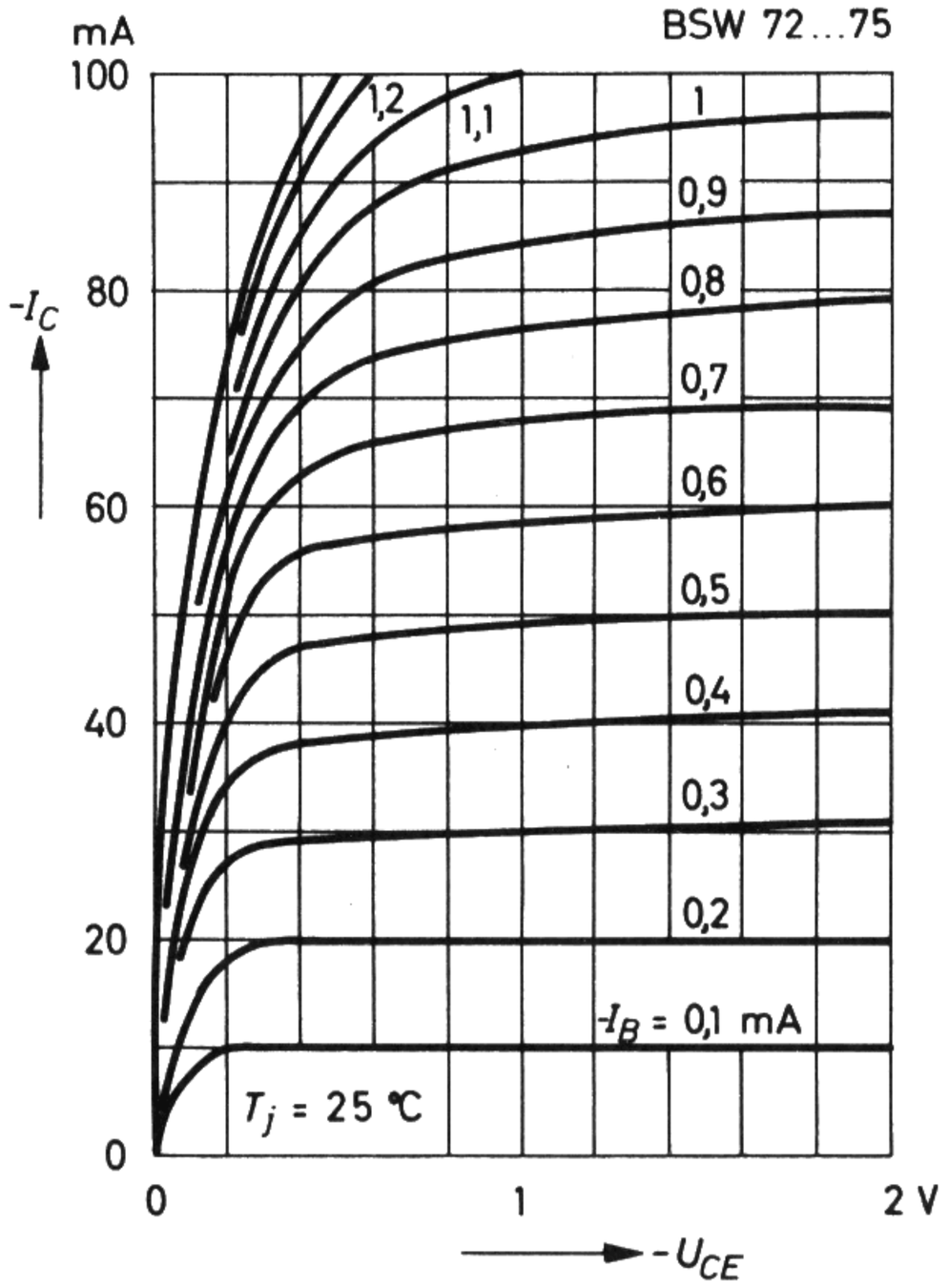
zulässige Gesamtverlust-leistung in Abhängigkeit von der Temperatur



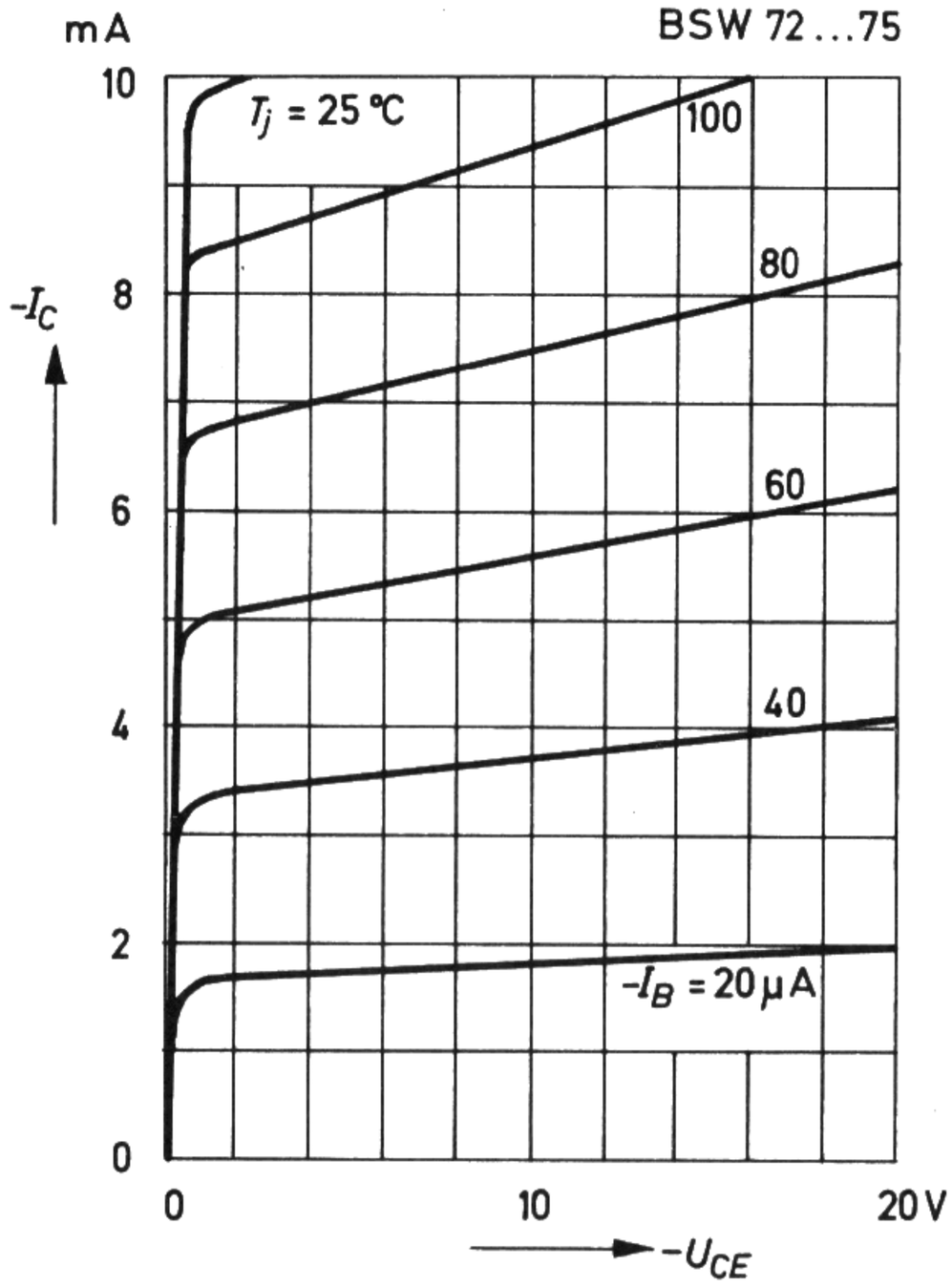
Impuls-Wärmewiderstand in Abhängigkeit von der Impulsdauer



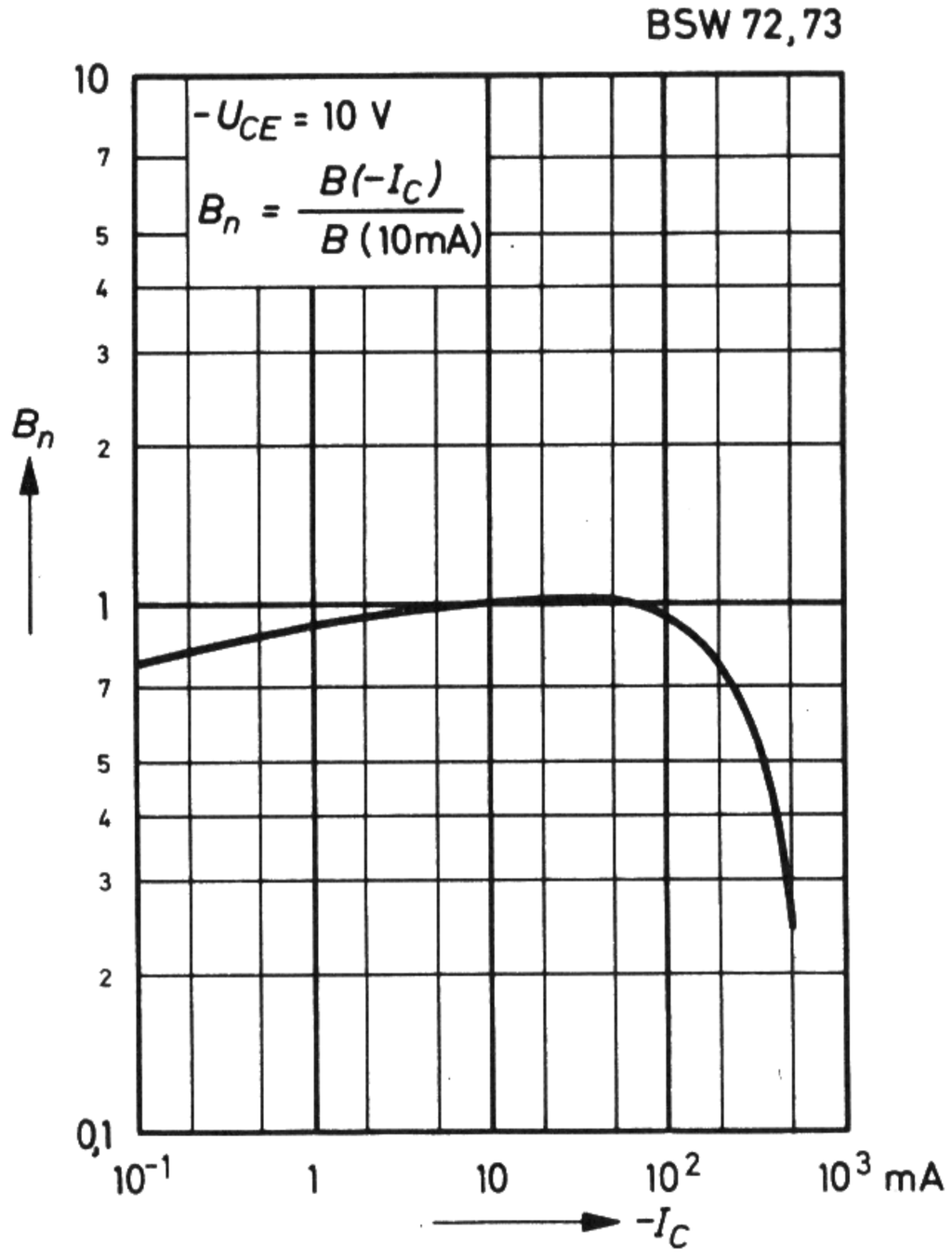
Ausgangskennlinien
Emitterschaltung



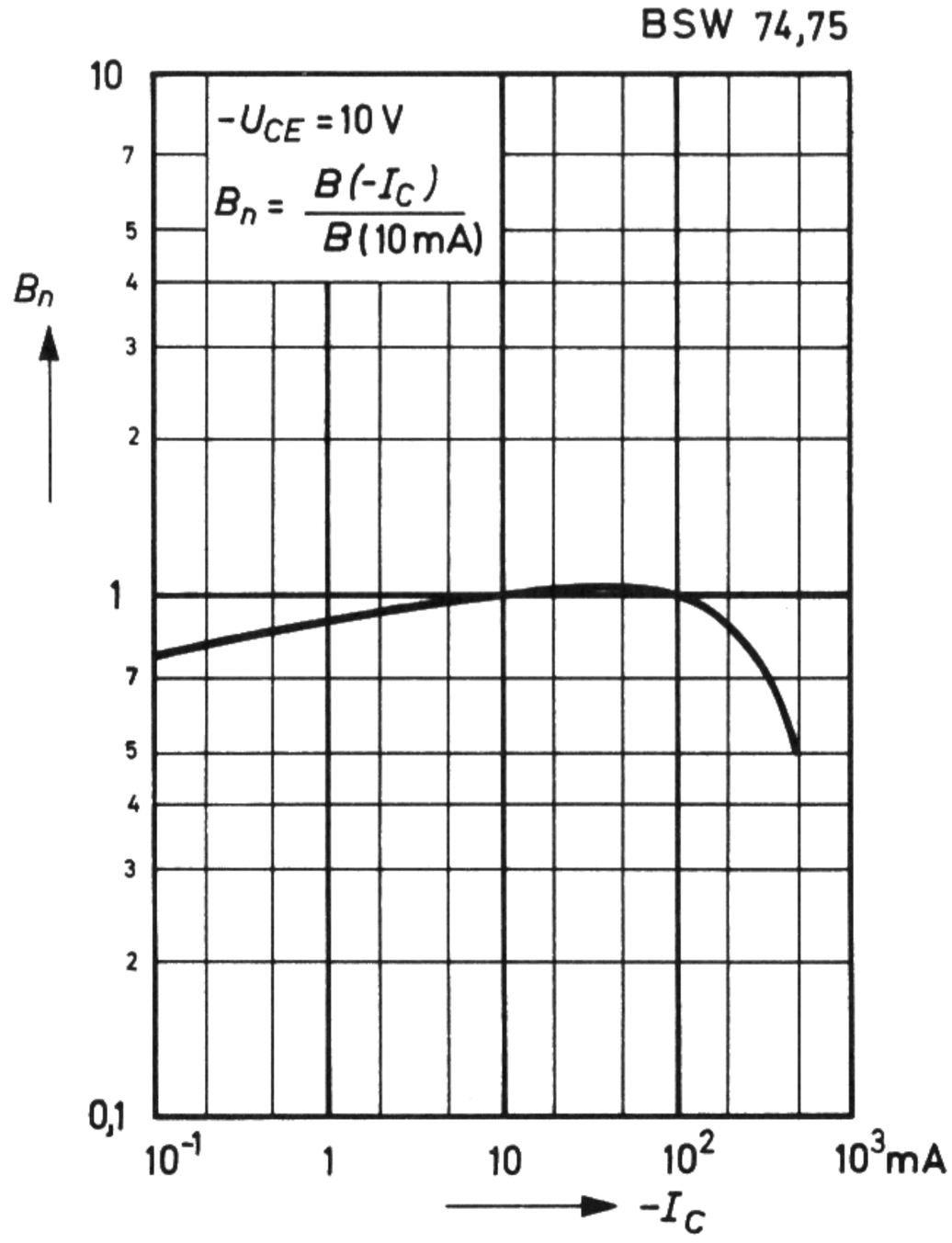
Ausgangskennlinien
Emitterschaltung



Kollektor-Basis-Stromverhältnis in Abhängigkeit vom Kollektorstrom

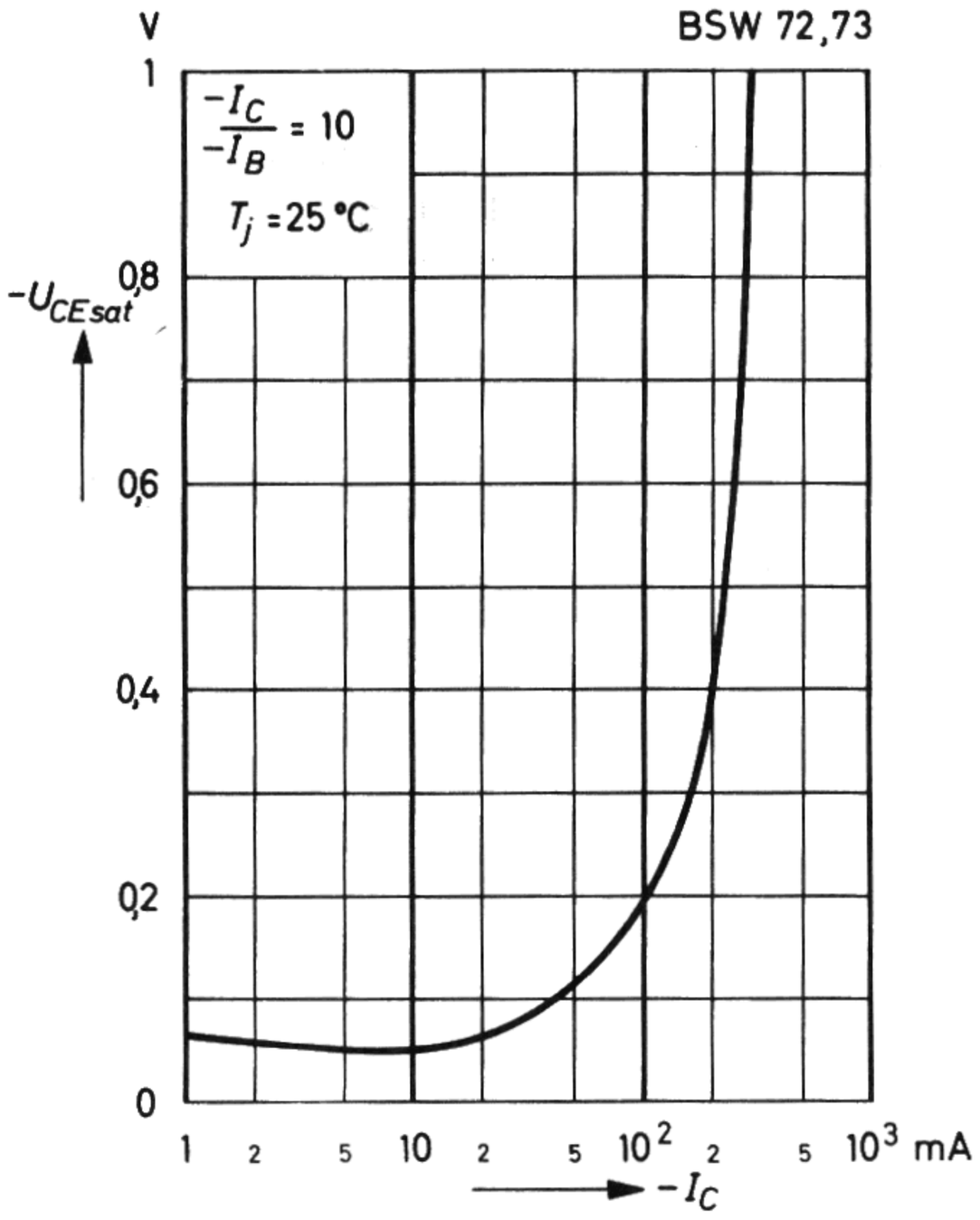


Kollektor-Basis-Stromverhältnis in Abhängigkeit vom Kollektorstrom



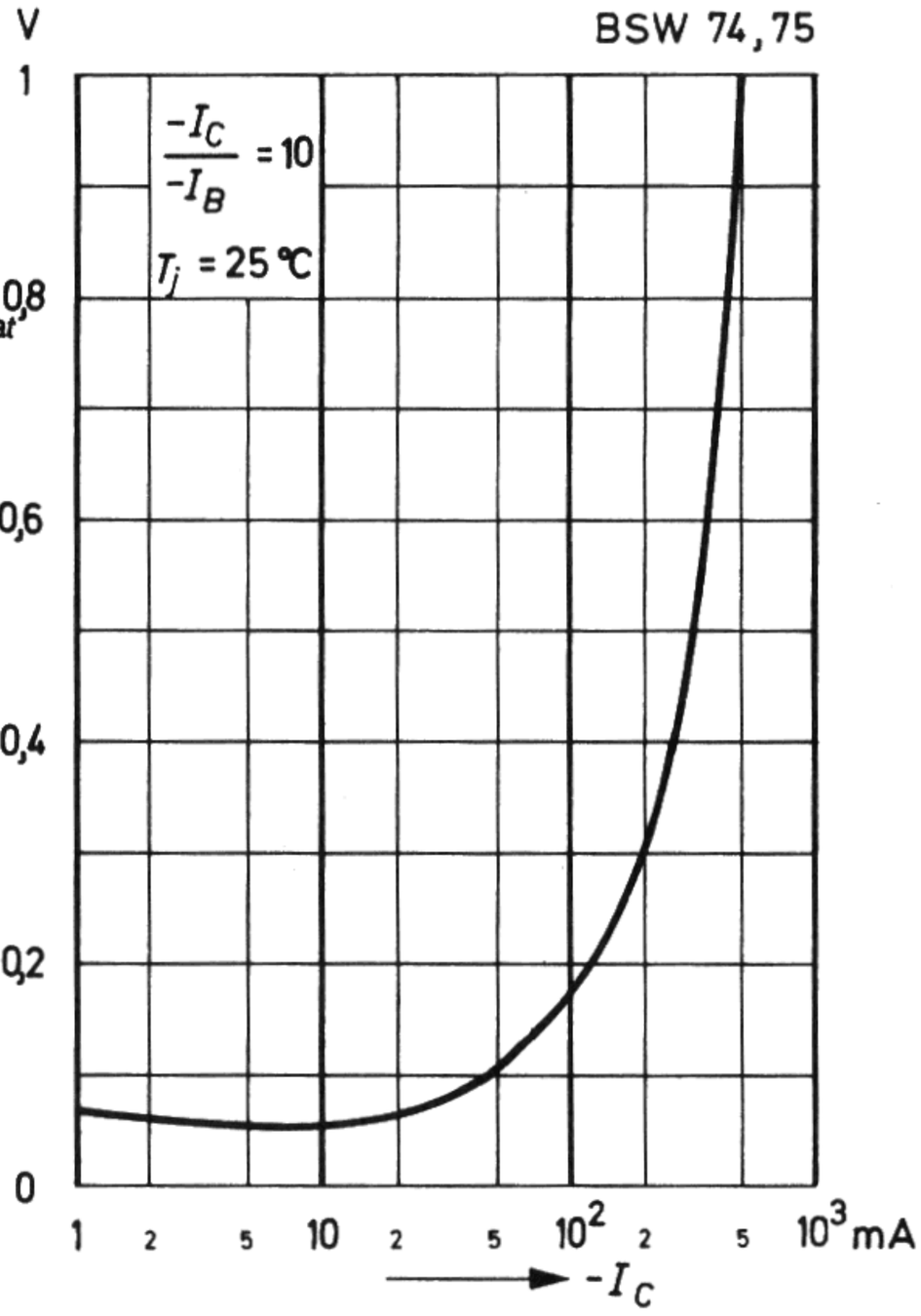
www.datasheetcatalog.com

Kollektor-Sättigungsspannung in Abhängigkeit vom Kollektorstrom

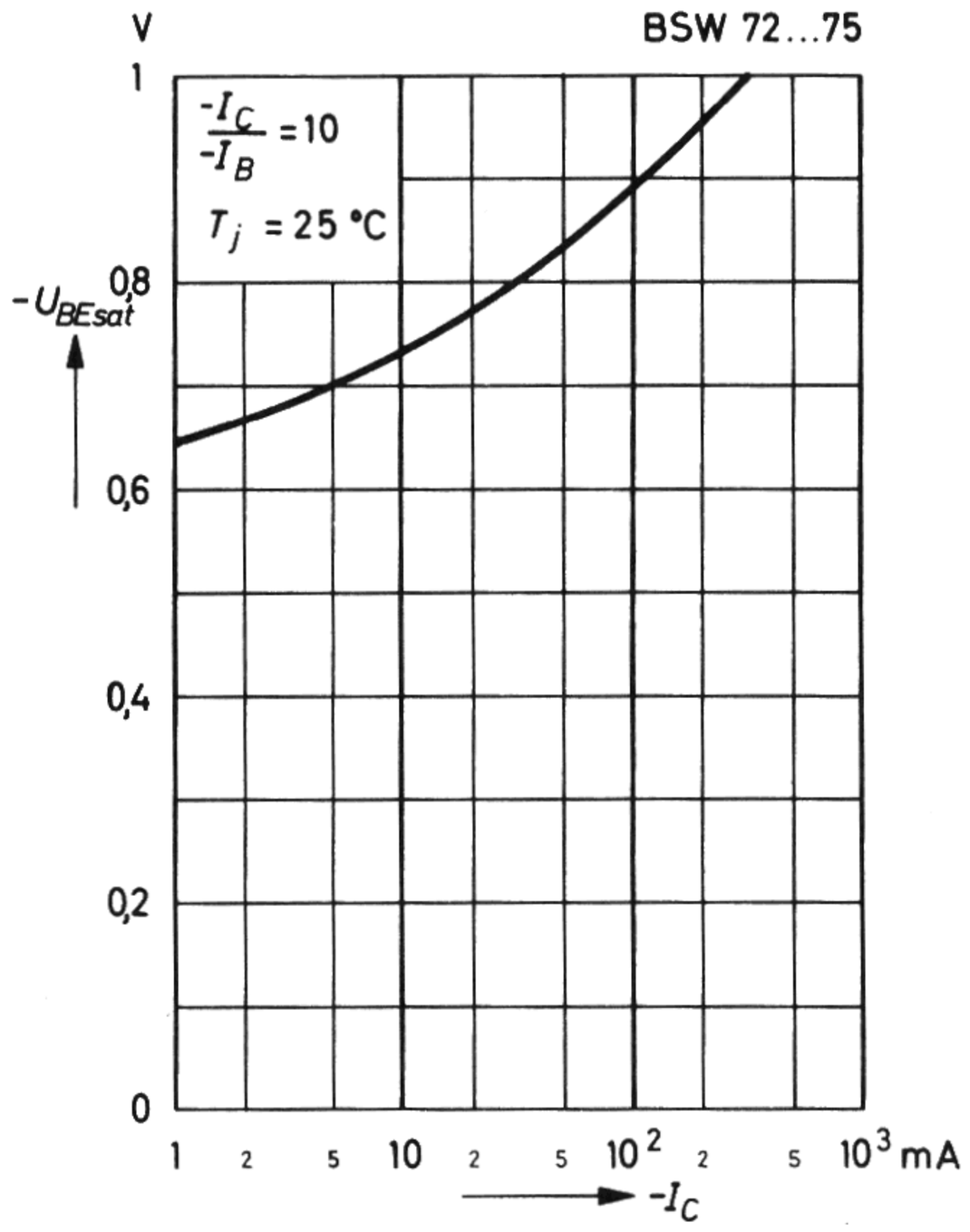


Kollektor-Sättigungsspannung in Abhängigkeit vom Kollektorstrom

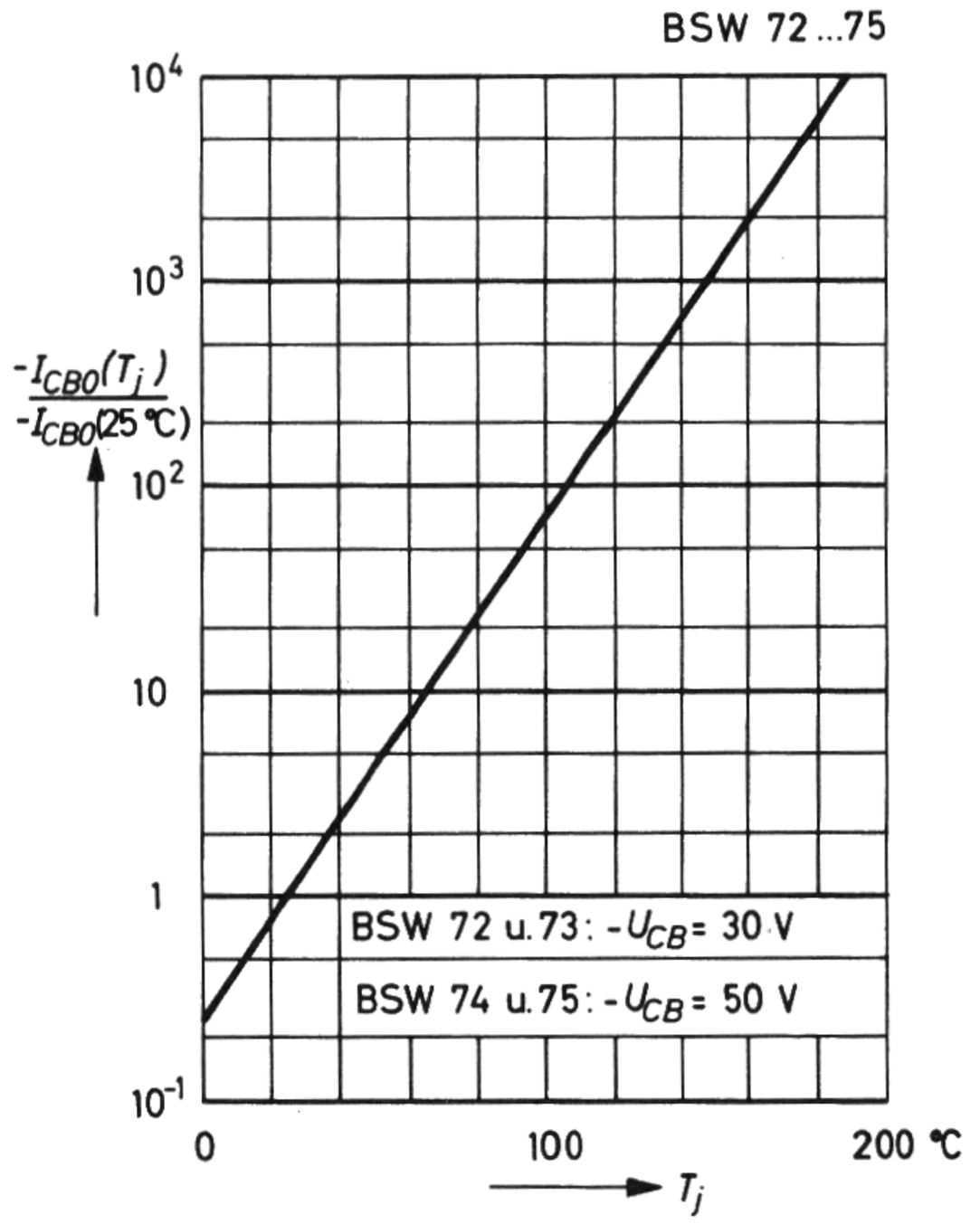
www.datasheetcatalog.com



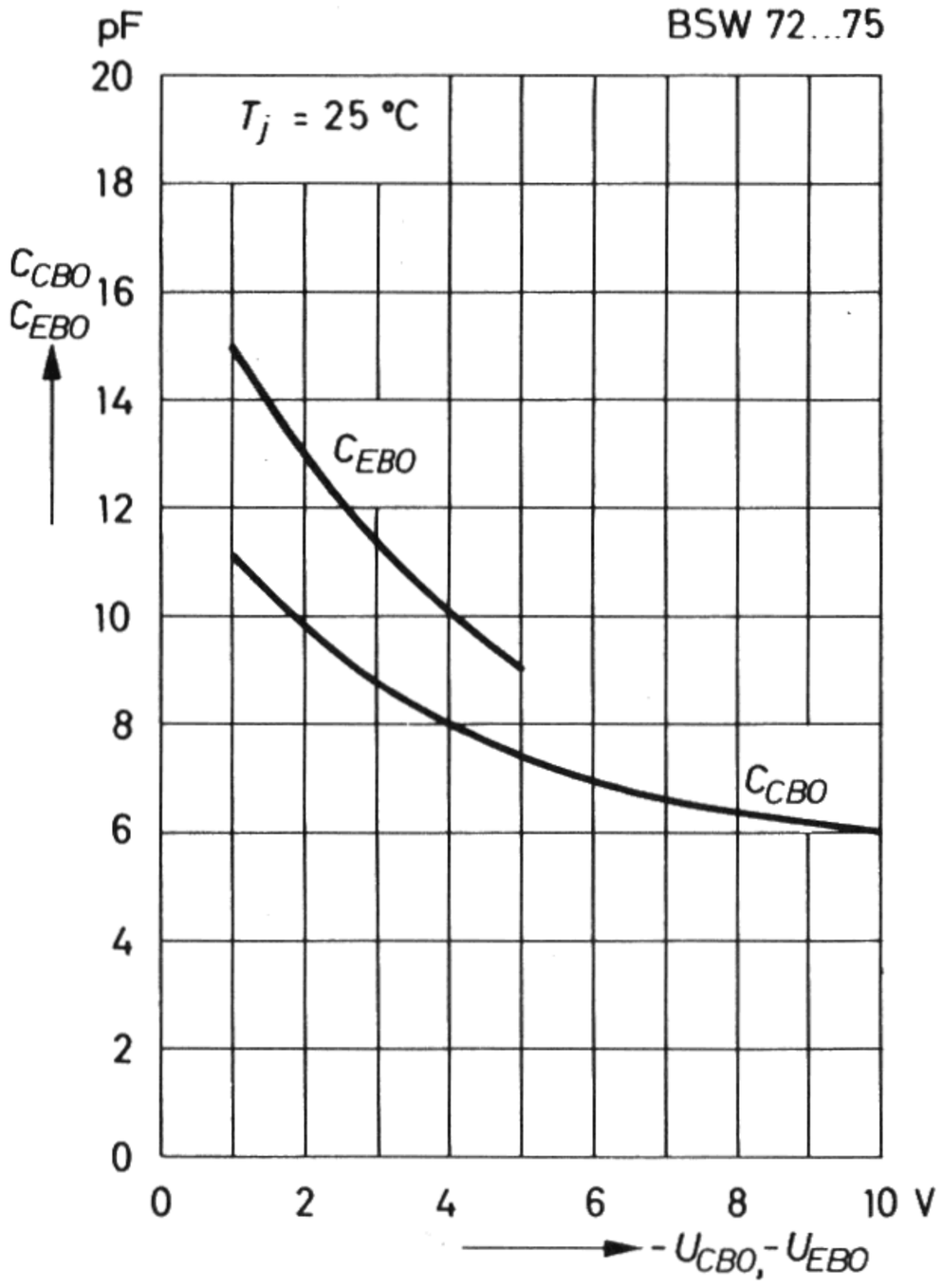
Basis-Sättigungsspannung in Abhängigkeit vom Kollektorstrom



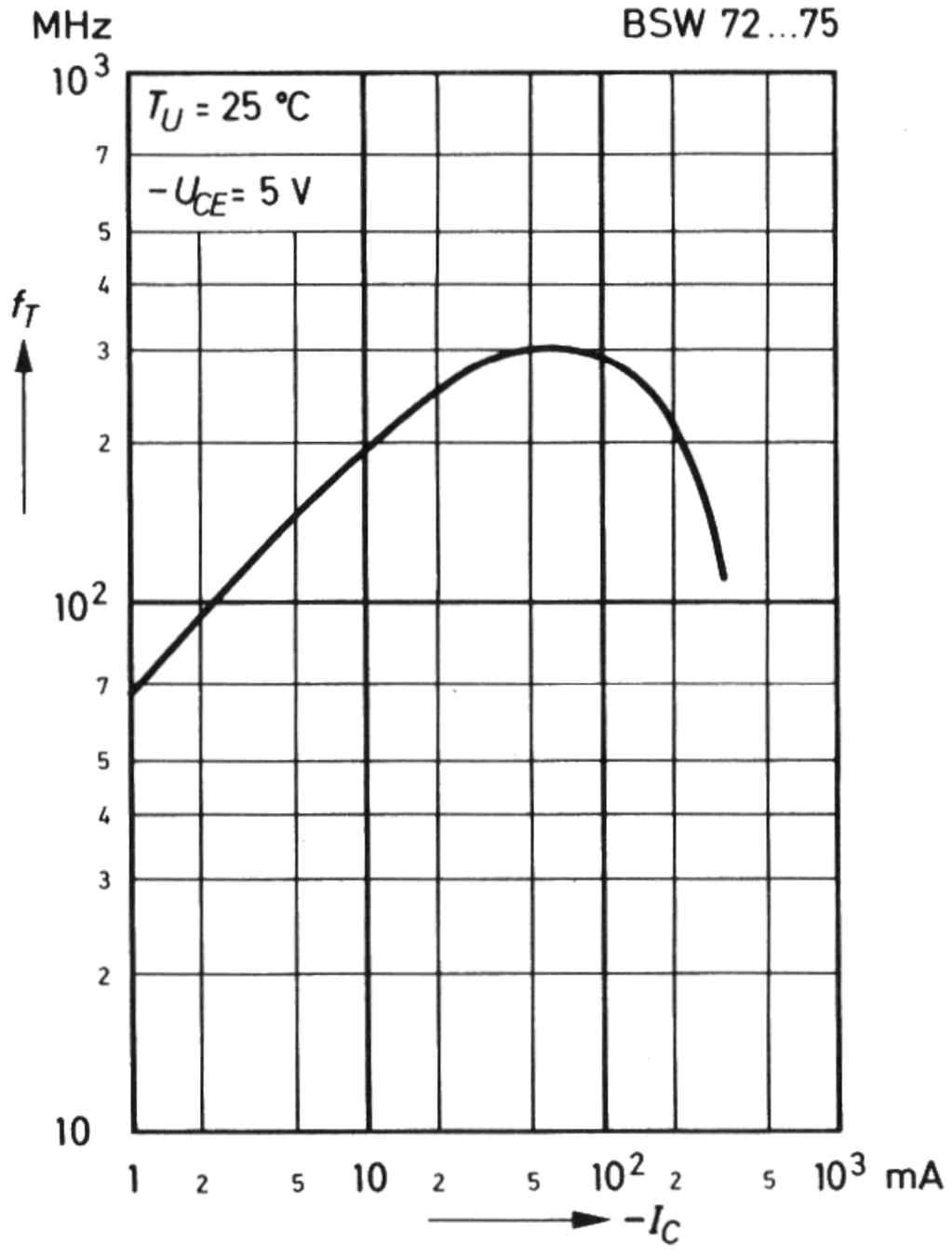
Kollektorreststrom in Abhängigkeit von der Sperrschichttemperatur



Kollektor-Basis- und Emitter-Basis-Kapazität in Abhängigkeit von der Sperrspannung



Transitfrequenz in Abhängigkeit vom Kollektorstrom



www.datasheetcatalog.com